

事業概況—設備投資額・研究開発費

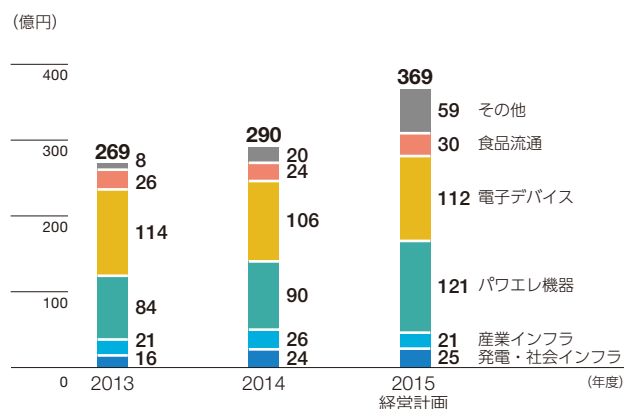
設備投資額

研究・技術開発棟の建設、生産能力増強と新製品開発強化

2014年度は、グローバルマザー開発拠点である全社研究開発棟(東京工場)、パワー半導体の技術開発棟(松本工場)の建設に着手しました。また、アジア・欧米向け製品の中核拠点であるタイ工場にパワエレ機器および電力用開閉装置の生産設備の投資を行いました。国内においては、スマートメータの自動化設備を導入するとともに、器具の開発棟(吹上工場)を建設し、評価設備の増強投資を行いました。さらに、パワー半導体第7世代IGBTの開発設備の導入を進めました。

2015年度は、パワエレ機器の競争力強化に向け、国内生産設備への投資を行うとともに、鈴鹿工場にパワエレテクニカルセンターを建設し、ものづくり力の強化、新製品開発の加速を図ります。また、全社研究開発棟、パワー半導体の技術開発棟を立ち上げるとともに、SiCパワーデバイスの開発設備を導入することにより、関連製品の開発、製品化を強化していきます。

設備投資額



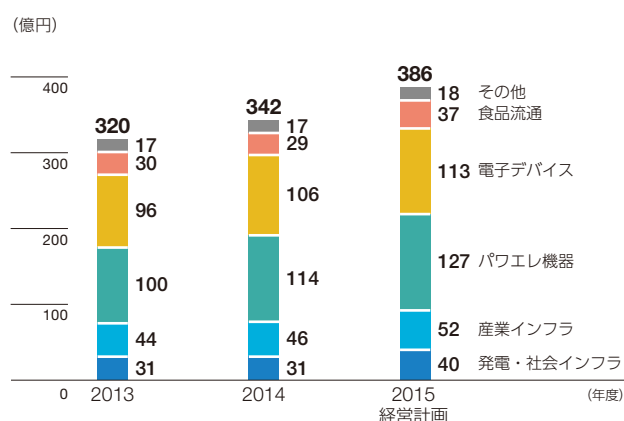
研究開発費

コア技術の徹底強化と新商材開発の加速

2014年度は、電子デバイスやパワエレ機器に注力し、SiCパワーデバイスやこのデバイスを搭載したパワーコンディショナ、インバータなどのパワエレ機器の開発を推進しました(詳細はP20~21「研究開発」を参照)。SiCパワーデバイスは、各種パワエレ機器の大幅な損失低減による省エネ化や小型化など高い革新性を持っています。売上拡大に向け、今後も同分野への投資を積極的に実施していきます。

2015年度は、革新的なソリューションをもたらすため、IoT(インターネット・オブ・シングス)やM2M(マシン・ツー・マシン)による、「もの、エネルギー、情報」を融合するソリューションに取り組むとともに、共通基盤・先端技術開発を継続的に強化します。さらに、海外事業の拡大に対応するため、現地開発・生産に適した基盤技術の開発を加速します。研究機関や大学との産官学連携を積極的に推進して、高い技術に挑戦するとともに開発のスピードアップを図ります。

研究開発費



※ 研究開発費をテーマに応じてセグメントに分類したもので、決算短信記載の数値とは異なります。